

Лекция №15

Плазменные волны в твердых телах (продолжение)

На предыдущем занятии нами рассматривались новые коллективные возбуждения в твердом теле – плазмоны, которые могут существовать в металлах и полупроводниках. Нами был получен спектр этих коллективных возбуждений

$$\omega^2(\mathbf{k}) = \omega_p^2 + \frac{\gamma}{m\nu_0} \mathbf{k}^2, \quad \omega_p^2 = \frac{4\pi e^2 \nu_0^2}{m}$$

При этом электронная подсистема рассматривалась как электронный газ.

Для выяснения пределов применимости теории плазмонов, построенной на предыдущей лекции, рассмотрим, при каких условиях оправдывается представление об электронах кристаллов как о непрерывной среде. Если принять, что электрон – точечная частица, то плотность и вектор потока электронов в точке \mathbf{r} можно записать в виде

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_l \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_l), \quad \mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sum_l \mathbf{v}_l \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_l), \quad (1)$$

где \mathbf{r}_l , \mathbf{v}_l – радиус-вектор и скорость l -го электрона, суммирование производится по всем электронам кристалла в единичном его объеме.

Будем учитывать только электростатическое взаимодействие. Потенциальная энергия взаимодействия i -го электрона со всеми другими электронами и положительным однородно распределенным зарядом ионов имеет вид:

$$U(\mathbf{r}_i) = \sum_j \left(\frac{e^2}{r_{ij}} - e^2 \int \frac{d\tau_j}{r_{ij}} \right), \quad r_{ij} \equiv |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|, \quad i \neq j \quad (2)$$

и интегрирование производится по единичному объему вокруг точки \mathbf{r}_j .

Пусть

$$\frac{e^2}{r_{ij}} = \sum_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}_{ij}) \quad \mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j.$$

Напомним, что функции

$$\varphi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$$

представляют собой полный набор ортонормированных функций. С учетом того обстоятельства, что рассматривается единичный объем, имеем

$$c_k = e^2 \int d\tau_j \frac{1}{r_{ij}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}_{ij}) = \frac{4\pi e^2}{\mathbf{k}^2} \text{ при } \mathbf{k} \neq 0$$

$$c_0 = e^2 \int \frac{d\tau_j}{r_{ij}}.$$

Таким образом, (2) преобразуется к виду

$$U(\mathbf{r}_l) = \sum_{j,k} \left[\frac{4\pi e^2}{\mathbf{k}^2} \exp[i\mathbf{k}(\mathbf{r}_l - \mathbf{r}_j)] \right]. \quad (3)$$

Знак «штрих» у суммы указывает на то, что отсутствуют слагаемые с $l = j$ и $\mathbf{k} = 0$.

Кинетическая энергия электронов имеет обычный вид

$$K = \frac{m}{2} \sum_l \mathbf{v}_l^2. \quad (4)$$

Из выражений (3), (4) следует уравнение движения для отдельных электронов

$$m\dot{\mathbf{v}}_l = -i4\pi e^2 \sum_j \left[\frac{\mathbf{k}}{\mathbf{k}^2} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}_{lj}) \right]. \quad (5)$$

Чтобы получить уравнение для плотности электронов, проведем предварительно Фурье-преобразования

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \rho_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}), \quad \mathbf{j}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{j}_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}).$$

Тогда, используя обратные преобразования Фурье, имеем

$$\rho_{\mathbf{k}} = \sum_l \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l), \quad \rho_0 = \nu_0, \quad \mathbf{j}_{\mathbf{k}} = \sum_l \mathbf{v}_l \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l) \quad (6)$$

Применяя к (6) уравнение непрерывности

$$\dot{\rho} + \text{div} \mathbf{j} = 0,$$

получим уравнения

$$\dot{\rho}_{\mathbf{k}} = -\sum_l i(\mathbf{k}\mathbf{v}_l) \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l), \quad (7)$$

$$\ddot{\rho}_{\mathbf{k}} = -\sum_l \left[(\mathbf{k}\mathbf{v}_l)^2 + i(\mathbf{k}\dot{\mathbf{v}}_l) \right] i \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l).$$

Подставив в последнее равенство значение $\dot{\mathbf{v}}_l$ из (5), находим, используя (6)

$$\ddot{\rho}_{\mathbf{k}} = -\frac{4\pi e^2}{m} \sum_{\mathbf{q}} \frac{\mathbf{k}\mathbf{q}}{q^2} \rho_{\mathbf{q}} \rho_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} - \sum_l (\mathbf{k}\mathbf{v}_l)^2 \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l). \quad (8)$$

Если в первом слагаемом правой части этого равенства выделить слагаемое $\mathbf{q} = \mathbf{k}$, то оставшуюся сумму $\sum_{\mathbf{q} \neq \mathbf{k}} \frac{\mathbf{k}\mathbf{q}}{q^2} \rho_{\mathbf{q}} \rho_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}$ можно опустить, так как она содержит большое число малых знакопеременных слагаемых. Отбрасывая эту сумму, мы пренебрегаем связью между изменениями Фурье-образов плотностей, относящихся к разным длинам волн. Такое приближение называется **приближением беспорядочных фаз**. Используя это приближение, преобразуем уравнение (8) к виду

$$\ddot{\rho}_{\mathbf{k}} + \omega_p^2 = -\sum_l (\mathbf{k}\mathbf{v}_l)^2 \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l), \quad (9)$$

где по-прежнему

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi e^2 v_0^2}{m}.$$

Правая часть этого уравнения зависит от скоростей электронов и при абсолютном нуле. Это движение оказывает разупорядочивающее действие на коллективные плазменные колебания. Его влияние тем меньше, чем меньше \mathbf{k} . Для оценки значений \mathbf{k} , при которых можно пренебречь правой частью (9), можно заменить \mathbf{v}_l максимальным значением скорости (скорость Ферми)

$$v_0 = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 v_0)^{1/3},$$

где v_0 - плотность электронов. Тогда

$$\sum_l (\mathbf{k}\mathbf{v}_l)^2 \exp(-i\mathbf{k}\mathbf{r}_l) < v_0^2 \mathbf{k}^2 \rho_{\mathbf{k}}.$$

Следовательно, при выполнении неравенства

$$\mathbf{k}^2 < \mathbf{k}_c^2 \equiv \frac{\omega_p^2}{v_0^2} \approx 6 \frac{v_0^{1/3}}{a_B}, \quad a_B \approx 5,3 \cdot 10^{-9} \text{ cm} \quad (10)$$

уравнение (9) переходит в уравнение коллективных плазменных колебаний

$$\ddot{\rho}_{\mathbf{k}} + \omega_p^2 = 0.$$

При выполнении неравенства (10) фазовая скорость плазмонов ω_p/k превышает максимальную скорость электронов. Поэтому переход энергии плазмонов в энергию отдельных электронов невозможен. Затухание плазмонов в твердом теле обусловлено взаимодействием с колебаниями решетки, с примесями и другими неоднородностями решетки.

Значение k , определяемое (10), можно принять за верхнюю границу волновых векторов плазмонов. Таким образом, волновые векторы плазмонов занимают центральную область зоны Бриллюэна объема $\frac{4\pi k_c^3}{V}$. Так как на

долю одного вектора приходится объем $\frac{(2\pi)^3}{V}$, то в кристалле может быть $\frac{Vk_c^3}{6\pi^2}$ плазмонов.

Элементарные возбуждения с $\mathbf{k}^2 > \mathbf{k}_c^2$ не имеют коллективного характера. При этих возбуждениях электронный газ следует рассматривать как систему отдельных квазичастиц с потенциальным взаимодействием

$$U_{sc}(\mathbf{r}) = \sum_{l \neq j} \sum_{\mathbf{k} > \mathbf{k}_c} \frac{4\pi e^2}{\mathbf{k}^2} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}_{lj}). \quad (11)$$

Итак, неучтенные в плазменных колебаниях взаимодействия электронов, расположенных на расстоянии \mathbf{r} друг от друга, определяются выражением

$$U_{sc}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k} > \mathbf{k}_c} \frac{4\pi e^2}{\mathbf{k}^2} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}). \quad (12)$$

Переходя в этом выражении от суммирования по \mathbf{k} к интегрированию, получим

$$U_{sc}(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{2\pi^2} \int_{k>k_c} d^3k \frac{\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})}{k} = \frac{2e^2}{\pi} \int_{k_c}^{\infty} dk \frac{\sin(kr)}{kr} \approx \frac{e^2}{r} \exp(-k_c r). \quad (13)$$

Таким образом, взаимодействие между электронами проявляется только на малых расстояниях $r < k_c^{-1}$. Выражение

$$\frac{e}{r} \exp(-k_c r)$$

Называется экранированным кулоновским потенциалом заряда e . Значению

$$k_c^2 \equiv \frac{\omega_p^2}{v_0^2} = \frac{2\pi e^2 n_0}{E_F},$$

где $E_F = \frac{1}{2} m v_0^2$ - энергия Ферми, соответствует квадрат радиуса экранирования (радиус экранирования Томаса - Ферми)

$$\lambda_{TF}^2 = \frac{E_F}{2\pi e^2 v_0}.$$

При вычислении λ_{TF}^2 мы исходили из предположения, что плотность электронов в металле велика, и они занимают все состояния с энергией $E < E_F$ (вырождение).

В полупроводниках плотность электронов мала и вырождение не осуществляется. Распределение электронов по энергиям определяется законом Больцмана. Взаимодействие электронов экранируется и в этом случае так, что кулоновское взаимодействие $e^2/\varepsilon_0 r$ заменяется экранированным кулоновским взаимодействием

$$U(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{\varepsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right),$$

где λ_D - дебаевский радиус экранирования

$$\lambda_D^2 = \varepsilon_0 kT / 4\pi v_0 e^2.$$

